한국IR협의회
기업리서치센터 기업분석 | 2026.11.05

KOSDAQ GLOBAL
코스닥글로벌상장법인
코스닥 글로벌 세그먼트

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

티씨케이 (064760)

증설과 고단화에 신규 적용처까지

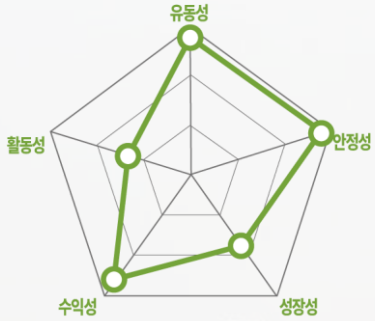
체크포인트

- SiC Focus Ring 글로벌 1위 업체로 Before Market에서 약 90%의 점유율을 확보. DRAM 신규 CAPA 확대에 따른 초도 장착 및 교체 수요 증가와 NAND 고단화 및 Triple Stack 전환에 따른 식각 공정 증가로 SiC Focus Ring 수요 확대 전망
- HBM TSV 및 Logic 공정으로 SiC Focus Ring 적용처 확대 추진 중. 현재 고객사 인증이 진행되고 있으며 2027년부터 양산 적용 기대. 신규 제품인 SiC Shower head도 고객사 확대를 위한 평가가 진행 중으로 기존 제품의 적용처 확대와 신규 제품을 통한 매출 다변화 기대
- 2026F 매출액 4,182억 원(+38.8% YoY), 영업이익 1,152억 원(+37.3% YoY)을 전망. 2027F 매출액 5,247억 원(+25.5% YoY), 영업이익 1,546억 원(+34.2% YoY)을 예상. DRAM 증설과 NAND 고단화 효과가 지속되는 가운데 생산능력 확대와 판매수수료 감소로 수익성 개선 전망

주가 및 주요이벤트

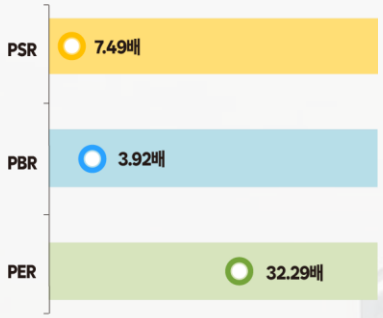


재무지표

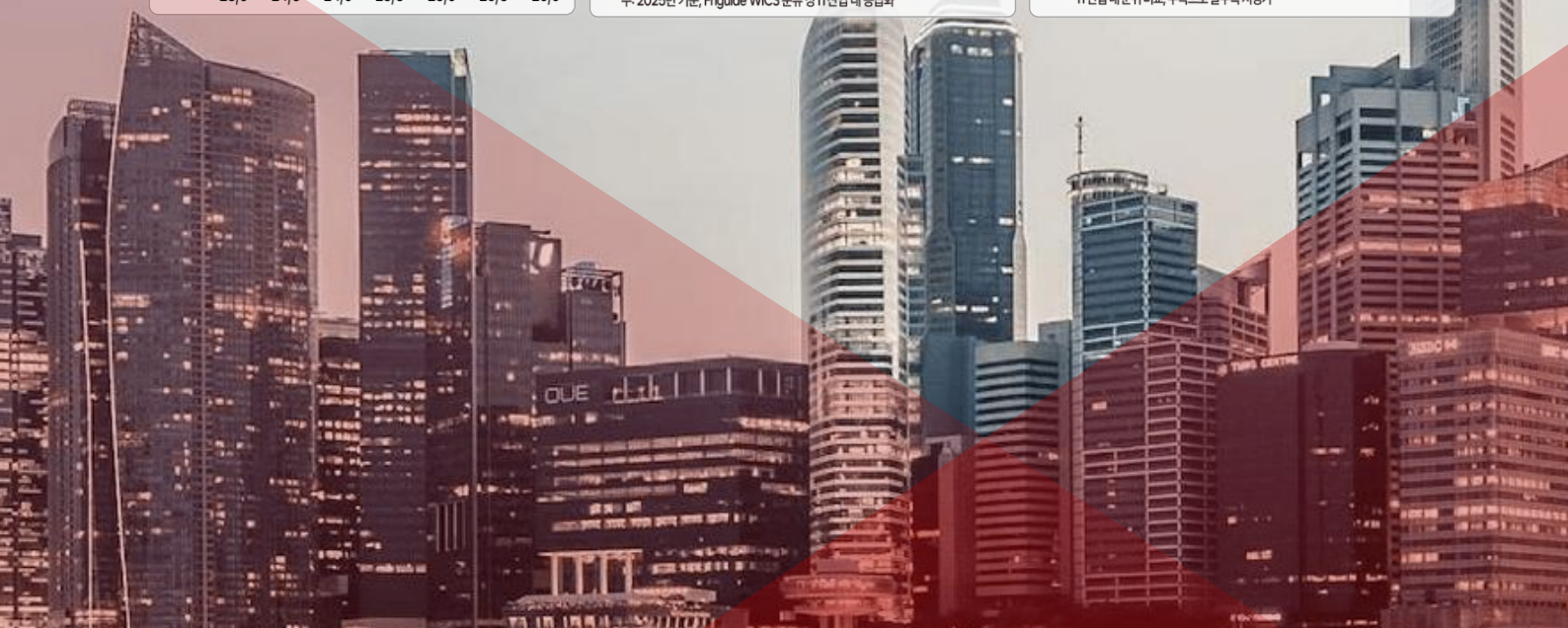


주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



티씨케이 (064760)

KOSDAQ
반도체와반도체장비

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr
RA 김지은 jekim0216@kirs.or.kr

SiC Focus Ring 글로벌 1위 업체

동사는 반도체 식각 공정에 사용되는 SiC Focus Ring 제조 업체. Solid SiC가 전체 매출의 약 90%를 차지하며, Focus Ring이 전체 매출의 약 80%를 차지. 글로벌 주요 식각 장비 업체에 제품을 공급하고 있으며, Before Market에서 약 90%의 점유율을 확보. 이외 Graphite 및 SiC/TaC Coated 부품 등을 생산

DRAM 증설과 NAND 고단화, 신규 적용처 확대

DRAM 신규 CAPA 투자와 NAND 고단화에 따른 SiC Focus Ring 수요 증가 전망. DRAM은 신규 장비의 초도 장착과 가동 이후 교체 수요가 증가할 것으로 예상. NAND는 고단화와 Triple Stack 전환에 따른 식각 공정 증가로 SiC 사용량 확대 전망. 또한 HBM TSV 및 Logic 공정으로 SiC Focus Ring 적용처 확대를 추진 중. 현재 고객사 인증이 진행 중이며 2027년부터 양산 적용 기대. 신규 제품인 SiC Shower head도 고객사 확대를 위한 평가 진행 중

CAPA 확대로 성장 지속되는 2027년

2026F 매출액 4,182억 원(+38.8% YoY), 영업이익 1,152억 원(+37.3% YoY)을 전망. 2027F 매출액 5,247억 원(+25.5% YoY), 영업이익 1,546억 원(+34.2% YoY)을 예상. DRAM 신규 CAPA 확대와 NAND 고단화 효과가 지속되는 가운데 기존 공장 증설과 생산 효율화로 2027년 생산능력 20~30% 증가 예상. 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화와 판매수수료 감소로 2027년 영업이익률은 전년 대비 1.9%p 상승한 29.5%를 전망

Forecast earnings & Valuation

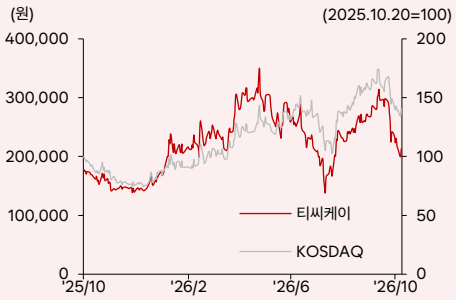
	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액(억 원)	2,267	2,757	3,013	4,182	5,247
YoY(%)	-29.1	21.7	9.3	38.8	25.5
영업이익(억 원)	667	807	839	1,152	1,546
OP 마진(%)	29.4	29.3	27.8	27.6	29.5
지배주주순이익(억 원)	612	720	699	964	1,272
EPS(원)	5,246	6,167	5,996	8,620	11,375
YoY(%)	-34.9	17.6	-2.8	43.7	32.0
PER(배)	21.2	11.5	23.7	20.6	15.6
PSR(배)	5.7	3.0	5.5	4.8	3.8
EV/EBITDA(배)	13.1	5.7	14.1	12.5	9.0
PBR(배)	2.8	1.6	3.1	3.3	2.8
ROE(%)	14.0	14.8	13.5	17.2	19.4
배당수익률(%)	1.1	2.0	1.0	0.8	0.8

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재가(11/03)		177,700원
52주 최고가		348,500원
52주 최저가		138,200원
KOSDAQ(11/03)		704.39p
자본금		58억원
시가총액		19,866억원
액면가		500원
발행주식수		11백만주
평균거래량(60일)		7만주
평균거래대금(60일)		174억원
외국인지분율		66.92%
주요주주	TOKAI CARBON CO., LTD.	52.6%
	(주)케이씨	6.9%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-40.0	-39.6	10.0
상대주가	-23.9	2.3	42.9

▶ **참고** 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '총자산회전율,' 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶ **'글로벌 세그먼트'**는 코스닥 시장 내 재무실적과 시장평가, 기업지배구조가 우수한 기업으로 한국거래소에서 선정한 기업

기업 개요

1 티씨케이는 반도체 공정용 SiC(실리콘카바이드) 부품 전문기업

1996년 설립돼 2003년 코스닥 상장한 반도체 공정용 SiC 부품 전문기업

티씨케이는 SiC(실리콘카바이드) 링을 비롯한 반도체 공정용 부품 제조기업으로, 사명은 'Tokai Carbon Korea'의 약자다. 전량 수입에 의존하던 고순도 흑연 제품의 국산화를 위해 1996년 8월 일본 탄소 소재 전문기업 TOKAI CARBON, 케이씨텍(현 케이씨), 슝크카본테크놀로지의 합작투자로 설립됐다. 1997년 경기도 안성에 제1공장을 준공해 생산을 시작했으며, 2001년 현재의 사명으로 변경한 뒤 2003년 8월 코스닥시장에 상장했다.

설립 초기에는 반도체·태양전지용 실리콘 잉곳 성장장비에 사용되는 고순도 흑연 부품의 국산화에 주력했다. 최대주주인 TOKAI CARBON으로부터 흑연 소재를 조달하고, 국내에서 가공·고순화·코팅을 수행하는 일괄생산체제를 구축했다. 이후 SiC 제품으로 사업 영역을 넓혀 2000년 SiC 웨이퍼 생산을 시작했으며, 2002년 CVD-SiC로(爐) 도입과 2010년 LED용 Susceptor 상용화를 통해 SiC 코팅 부품 사업을 확대했다.

현재의 주력 사업인 SiC 포커스링 사업은 2013년 식각장비용 CVD SiC 포커스링을 최초로 상용화하면서 시작됐다. 이듬해 주요 식각장비 제조사향 OEM 공급을 본격화하며, 장비사를 통해 반도체 제조사에 제품을 공급하는 사업구조를 형성했다. 이후 SiC 포커스링을 주력 제품으로 육성했으며, Solid SiC 제품군 확장을 통해 현재는 샤워헤드와 더미 웨이퍼 등을 포함한다.

동사의 주요 거래처에는 Lam Research, Applied Materials, 도쿄일렉트론, AMEC 등 글로벌 반도체 장비사와 실리콘 웨이퍼 제조사 SK실트론이 있으며, 이들 기업으로부터 우수협력사상을 수상해 왔다. 수출 규모도 확대돼 2016년 2천만불, 2018년 7천만불에 이어 2021년 1억불 수출의 탑을 수상했다. 대외적으로는 2020년 반도체의 날 국무총리표창을 받았고, 2022년 코스닥 글로벌 세그먼트 편입, 2023년 KOTRA 세계일류상품 인증, 2026년 기업가치 제고 우수기업 금융위원장상 수상 등의 이력을 보유하고 있다.

티씨케이 연혁

1996~2009

1996.08	한국도카이카본(주)설립
1997.09	1공장 준공
1998.10	ISO9001 : 1994 인증
2000.04	SiC Wafer 생산 개시
2001.03	국무총리상 수상(상공업진흥)
2001.10	상호변경(주식회사 티씨케이)
2002.10	CVD-SiC로(爐) 국내 최초 도입
2003.08	코스닥 상장
2004.02	신기술 · 신경영 대상 수상(코리아헤럴드)
2004.12	기업부설연구소 설립
2005.11	백만불 수출의 탑 수상
2006.06	InnoBiz 인증(중소기업청)
2006.11	3백만불 수출의 탑 수상
2006.12	ISO14001 : 2004 인증
2007.01	디지털 이노베이션 대상(산업자원부 장관상)
2008.03	녹색에너지 우수기업 대상 수상 (태양전지용 초고순도 흑연제품부문)
2008.04	대한민국 선도기업 선정(카본 소재 부분)
2008.06	대한민국 코스닥 대상 수상 (최우수테크노경영상)

2010~2019

2010.02	LED Susceptor 상용화
2011.09	2공장 준공
2013.07	CVD SiC Ring 상용화
2014.02	Carbon Chuck for Poly Si Reactor 상용화
2015.12	대한민국 기술대상 수상 (산업통상부 장관상)
2016.11	KOSHA18001 인증
2016.12	무역의 날 2천만불 수출의 탑 수상
2017.09	Lam Research 협력사의 날, 우수 협력사 수상,2016
2017.12	Applied Materials 협력사의 날, Accelerated Growth & Performance 수상
2017.12	3천만불 수출의 탑 수상
2017.12	주성엔지니어링 우수 협력사 수상,2017
2018.02	삼성 원자재/부품 우수 협력사 수상,2017
2018.11	벤처 1,000억 기업 수상
2018.12	7천만불 수출의 탑 수상
2019.03	삼성 원자재/부품 우수 협력사 수상,2018
2019.06	대한민국 코스닥 대상 수상 (최우수투명경영상)
2019.10	신축공장 준공

2020~

2020.09	도쿄일렉트론코리아 우수협력사 공로패 수상
2020.10	반도체의 날 국무총리표창 수상
2020.11	SK Siltron 우수 협력사 수상,2020
2020.12	SEMI INNOVATION AWARD 수상
2020.12	Applied Materials 협력사의 날, Excellence in Aftermarket Support 수상
2021.09	도쿄일렉트론코리아 우수협력사 공로패 수상
2021.10	Lam Research 협력사의 날, Ramp Performance Award 수상
2021.12	1억불 수출의 탑 수상
2022.02	AMEC Best Supplier Award
2022.05	SEMES 최우수 공로상 수상
2022.10	SK Siltron 베스트 파트너상 수상
2022.11	KOSDAQ Global Segment 편입
2023.06	AMEC 2022 우수협력사상 수상
2023.11	KOTRA 2023 세계일류상품 인증서 수여
2023.11	SK Siltron 베스트 파트너상 수상
2024.06	ISO/IEC 27001 정보보호경영시스템 인증 획득
2024.07	산업통상자원부 첨단기술 제품 확인서 취득
2024.09	LAM Research Best Supplier Award 수상
2024.11	SK Siltron Appreciation Award 수상
2025.11	TEL Excellent Achievement
2025.11	SK실트론 베스트 파트너상
2026.03	AMEC Excellent Quality Performance 수상
2026.06	'2026 기업가치 제고 우수기업' 금융위원장상 수상

자료: 티씨케이, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 주요 사업 및 매출 구성

1H26 기준 매출 비중은 Solid SiC 89.8%, Graphite 7.3%, Susceptor 2.7%, 기타 0.2%

동사의 주요 사업은 Solid SiC, Graphite, Susceptor 부문으로 구분된다. 1H26 기준 매출 비중은 Solid SiC 89.8%, Graphite 7.3%, Susceptor 2.7%, 기타 0.2%를 기록하였다.

Solid SiC

Solid SiC 부문은 CVD(Chemical Vapor Deposition) 공법을 통해 생산한 고순도 SiC 부품으로 반도체 식각 및 확산 공정에 사용되는 SiC Focus Ring, Shower Head, Dummy Wafer 등을 생산한다. 주력 제품인 SiC Focus Ring은 반도체 식각 챔버 내에서 웨이퍼 가장자리를 둘러싸 플라즈마 분포를 균일하게 유지하고 정전척을 보호하는 소모성 부품이다. SiC는 기존 Si 대비 내플라즈마성과 내화학성이 우수하여 교체주기가 길고 파티클 발생을 줄일 수 있어 반도체 미세화 및 고단화에 따라 채택이 확대되고 있다. SiC Shower Head는 식각 챔버 내부에 공정 가스를 균일하게 공급하는 부품으로, 기존 Si 소재 대비 내식각성이 우수하고 수명이 길다. SiC Dummy Wafer는 반도체 증착 및 확산 공정에서 실제 생산용 웨이퍼 대신 투입되어 챔버 내부의 공정 조건을 안정화하는 부품이다. 기존 Si Wafer 대비 표면 증착물 제거 및 세정 작업을 줄일 수 있다는 장점이 있다.

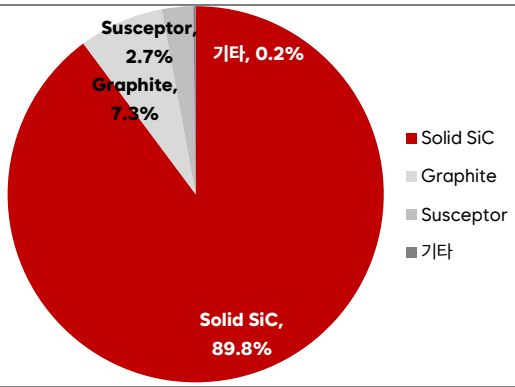
Graphite

Graphite 부문은 반도체용 실리콘 Wafer 및 태양전지용 Wafer를 생산하는 Crystal Grower 장비에 사용되는 고순도 흑연 부품을 생산한다. 주요 제품은 Hotzone, Heater, Crucible, Reflector 등으로, 실리콘 잉곳 성장 과정에서 고온 환경을 유지하고 열을 균일하게 전달하는 역할을 한다. 흑연은 높은 내열성과 열전도율, 낮은 열팽창 특성을 가지고 있어 고온 공정의 장비 부품으로 사용된다.

Susceptor

Susceptor 부문은 흑연 소재 표면에 SiC 또는 TaC를 코팅한 부품을 생산한다. SiC Coated Susceptor는 반도체 ALD 및 Si Epitaxy, LED MOCVD 공정에서 웨이퍼를 지지하고 열을 균일하게 전달하는 역할을 한다. TaC Coated Susceptor는 SiC 전력반도체용 Epitaxy 공정에 사용되며, 고온에서의 안정성과 내화학성이 우수한 TaC 소재를 적용한 제품이다.

티씨케이 매출 비중



주: 1H26 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 사업 영역

Product category	Product	Application	Major Customer(In ABC order)
Solid SiC	SiC Focus Ring	Etcher	AMAT/AMEC/LAM/SAMSUNG/SEMES/TEL
	SiC Dummy W/F	Diffusion	SAMSUNG/SK Hynix
	SiC Shower Head	Etcher	AMEC
Pure Graphite	High purified	Si Grower	Hana Materials
	Standard	PV/Industry	OCI
	Hot zone	Si Grower	MEMC/Silfex/SK Siltron/WCQ
Coated product	Susceptor	ALD/LED	JUSUNG/SAMSUNG/Seoul Viosys/WONIK IPS
	Upper Ground Ring	Etcher	AMEC
	Pyro Coating	Si Grower	SK Siltron/Zingsemi
	TaC Coating	UVLED	TES
		Single SiC	ST Micro/Sanan IC/Tankeblue

Starting Material: Graphite

자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 주주 구성

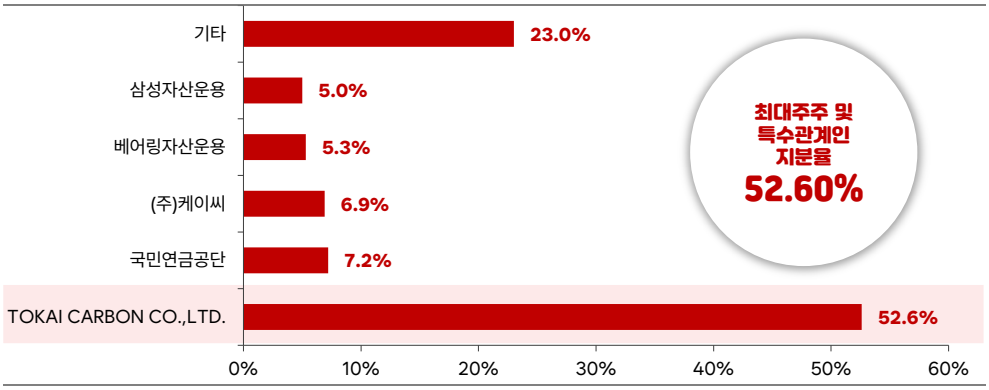
최대주주는 일본 TOKAI CARBON으로 지분 52.6% 보유

1H26말 기준 티씨케이의 최대주주는 일본 TOKAI CARBON CO., LTD.로 지분 52.6%(5,883,250주)를 보유하고 있다. TOKAI CARBON은 1918년 설립된 도쿄 소재의 탄소제품 종합 제조사로, 카본블랙·흑연전극·파인카본·마찰재 등을 생산한다. 동사 설립 당시 합작투자자로 참여했고, 2018년 동사를 그룹 자회사로 편입했다. 동사는 TOKAI CARBON의 FC사업부장을 맡고 있는 카나이 켄이치 대표이사 회장과 오창민 대표이사 사장이 이끌고 있다.

최대주주 지분이 과반을 넘어, 최대주주가 주주총회 보통결의를 단독으로 통과시킬 수 있는 지배 기반을 갖추고 있다. 2대주주인 ㈜케이씨(6.9%)는 설립 당시 합작투자자였던 케이씨텍의 현 사명이다. 반기말 기준 5% 이상 주주는 TOKAI CARBON과 ㈜케이씨 외에 국민연금공단(7.2%), 베어링자산운용(5.3%), 삼성자산운용(5.0%) 등 기관투자자 3곳이다. 소액주주는 19,245명으로 발행주식총수의 34.1%를 보유하고 있다. 동사가 보유한 자기주식은 없으며, 2025년 12월 보유 자기주식 495,584주(약 500억 원)를 전량 이익소각했다.

반기말 이후에는 기관투자자 지분이 줄었다. 국민연금공단은 장내매도로 보유 지분이 2026년 7월 14일 기준 6.25%(699,186주)로 낮아졌다고 보고했다. 베어링자산운용은 9월 8일 기준 4.28%(478,272주)로 지분이 줄어 5% 이상 주주에서 빠졌다. 두 기관의 보유목적은 모두 단순투자다.

티씨케이 주주 현황



주: 1H26 기준, 자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

산업 현황

1 10월 반도체 주가 급락과 과도한 CXMT 공급 확대 우려

10월 반도체 주가는 CXMT 4F² 발표와 하이퍼스케일러 FCF 악화 우려로 AI 버블 논란 속 급락

2026년 10월 반도체 주가는 AI 버블 우려가 확대되면서 큰 폭으로 하락하였다. 9월 고점 대비 10월 저점까지 SOX 지수는 -15.8%, KOSPI는 -22.8% 하락했으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 -26.4%, -34.5% 하락하였다. 국내 주요 반도체주는 실적 발표 이후 일부 반등했으나, SOX 지수는 10월 말 다시 하락하면서 높은 변동성이 이어졌다. 7월에는 상반기 급등에 따른 Valuation 부담과 AI 인프라 과잉투자 우려가 부각된 가운데, 신용융자 반대매매와 레버리지 포지션 청산이 매도 압력을 확대시키면서 주가가 급락하였다. 반면 10월에는 중국 CXMT의 4F² DRAM 기술 발표에 따른 공급 확대 가능성과 하이퍼스케일러들의 CAPEX 증가에 따른 FCF 악화 및 자금조달 부담이 부각되면서 AI 투자 수익성에 대한 의구심이 확대되었다. 특히 Meta가 3Q26 CAPEX 349억 달러를 집행하면서 FCF -21억 달러를 기록한 점이 투자 부담에 대한 우려를 높였다.

CXMT의 4F² 기술 발표만으로 단기간 내 DRAM 공급 확대를 우려하기는 어려움

다만 CXMT의 4F² 기술 발표만으로 단기간 내 DRAM 공급 확대를 우려하기는 어렵다고 판단한다. CXMT는 10월 4F² 셀 구조를 적용한 서버용 DDR5 RDIMM을 연내 공개할 계획이라고 발표하였다. 4F²는 DRAM 셀 면적을 최소 선폭(F) 제곱의 4배로 줄이는 구조로, 수직 채널 트랜지스터 등의 기술을 통해 구현할 수 있다. 동일한 최소 선폭을 가정하면 기존 6F² 대비 셀 면적을 약 33% 축소할 수 있다. 다만 셀 면적 축소가 실제 제품의 동일한 비율의 Bit Density 개선으로 연결되는 것은 아니며, 셀 동작 특성과 수율, 원가 경쟁력 확보가 필요하다. CXMT는 10월 30일 실적 설명회에서 4F² 기반 6세대 DRAM 공정 플랫폼의 엔지니어링 샘플 검증을 완료했다고 발표하였다. 실제 웨이퍼에서 핵심 성능 목표를 달성한 것으로, 기존 기술 개발 발표에서 제품화 검증 단계로 진전되었다. 다만 구체적인 제품 성능과 양산 수율은 공개되지 않았으며, 2026년 말 서버용 DDR5 RDIMM의 고객사 샘플 공급 이후 인증과 양산 전환이 진행될 예정이다. 대량 양산 시점 역시 고객 인증과 시장 수요에 따라 결정될 계획이다. 따라서 엔지니어링 샘플 검증은 기술 경쟁력 확보의 진전으로 평가할 수 있지만, 기존 DRAM 업체들과의 기술 격차가 해소되었다고 판단하기는 어렵다.

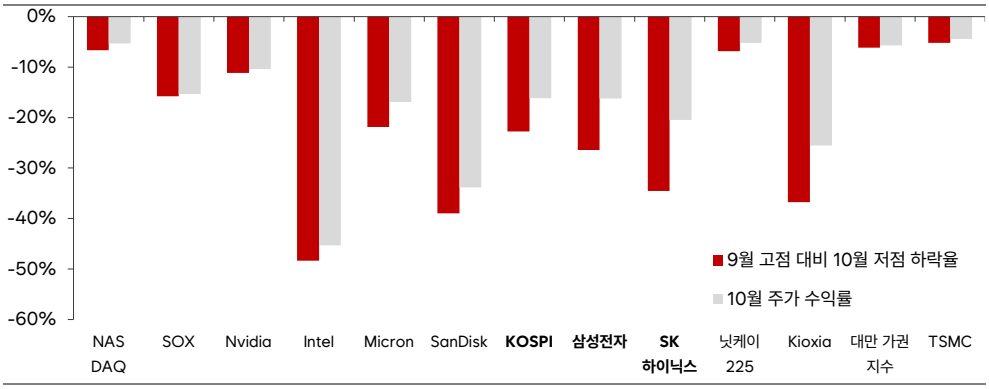
삼성전자·SK하이닉스는 4F² 양산에 신중한 입장이며 Micron은 6F² 미세화 전략을 유지

삼성전자와 SK하이닉스도 4F² DRAM을 개발하고 있지만, 양산 전환에는 신중한 입장이다. 삼성전자는 2026년 ISSCC에서 수직 채널 트랜지스터(VCT)와 웨이퍼 본딩을 적용한 4F² DRAM 시제품의 동작 결과를 공개했으며, 향후 양산 적용 가능성을 검토하고 있다. SK하이닉스 역시 4F² Vertical Gate와 3D DRAM을 차세대 기술 로드맵으로 제시했으며, 수직형 트랜지스터의 전기적 특성 개선을 위한 연구를 진행하고 있다. 반면 Micron은 10월 21일 기술 설명회에서 4F² 구조를 채택하지 않고 기존 6F² 구조의 미세화와 웨이퍼 본딩, 3D DRAM 개발에 집중하겠다는 전략을 발표하였다. DRAM의 실제 집적도는 트랜지스터뿐 아니라 캐패시터의 배치 간격에도 영향을 받기 때문에 4F² 구조만으로 충분한 원가 개선을 확보하기 어렵고, 수직형 트랜지스터의 공정 복잡성과 제조비용, 추가 미세화의 한계도 존재한다는 설명이다. 삼성전자와 SK하이닉스 역시 4F²와 함께 3D DRAM을 개발하고 있어, 4F²가 반드시 거쳐야 하는 필수적인 기술 단계라고 보기는 어렵다. 결국 향후 경쟁력은 기술 발표 시점보다 양산 수율과 제품 성능, Wafer당 생산 Bit 및 원가 경쟁력에 따라 결정될 전망이다.

CXMT는 공격적 가격 인하보다 기존 고객 공급을 우선

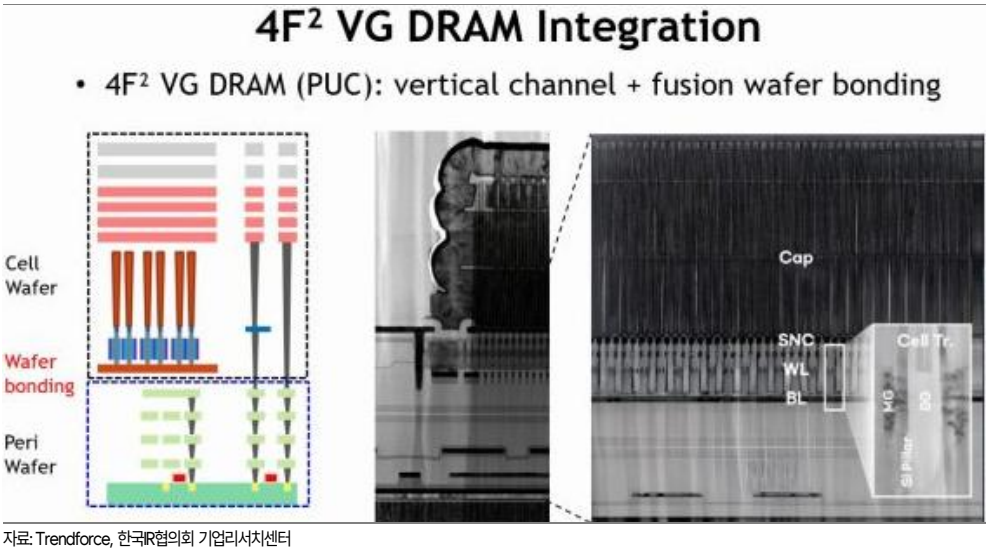
CXMT의 실제 판매 전략 역시 단기간 내 공격적인 공급 확대와는 거리가 있다. 최근 CXMT는 애플의 LPDDR5X 구매 협상에서 한국 메모리 업체 대비 낮은 가격을 요구받았으나 이를 수용하지 않아 공급 협상이 성사되지 않은 것으로 전해졌다. 중국 내 기존 고객사에 대한 물량 공급을 우선하고 있어 추가 고객에 배정할 수 있는 생산능력에도 제약이 있기 때문이다. 따라서 추가 고객 확보를 위해 가격을 낮출 유인이 크지 않은 것으로 판단한다. CXMT 주가 역시 $4F^2$ 기술 발표 이후 글로벌 메모리 업체들과 함께 하락했으나, 주가 흐름만으로 기술 경쟁력이나 양산 가능성을 판단하기는 어렵다. 오히려 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 주요 CSP들이 삼성전자와 SK하이닉스에 서버 DRAM 장기 공급계약(LTA)을 요청하고 있으며, 일부 고객사는 최대 10년의 공급계약을 추진하고 있다. 이는 중국 CSP들도 서버 DRAM의 안정적인 물량 확보를 위해 한국 메모리 업체와의 장기 공급관계를 필요로 하고 있다는 점을 보여준다.

주요 지수 및 반도체 주가 하락율



자료: Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

$4F^2$ DRAM 구조



자료: Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 AI 사용량과 클라우드 매출 증가가 뒷받침하는 인프라 투자

Token 가격 하락에도 사용량 증가로 AI 서비스 매출이 확대되며 인프라 투자 정당성 강화

AI 인프라 투자에 따른 FCF 악화 우려는 실제 AI 서비스 사용량 및 매출 증가와 함께 평가할 필요가 있다. AI 모델의 성능 개선과 추론 비용 하락으로 Token당 가격은 하락하고 있지만, 사용량 증가가 가격 하락을 상쇄하면서 AI 서비스 이용과 관련 지출이 확대되고 있다. Vercel AI Gateway 이용 고객 기준으로 2025년 12월 대비 2026년 9월 평균 Token 가격이 47% 하락한 반면 사용액은 약 13배 증가하였다. 특히 두 기간 모두 서비스를 이용한 유료 고객의 지출 중간값도 2배 이상 증가해 기존 고객의 AI 이용이 확대되고 있다. Anthropic도 3Q26 매출액이 168억 달러로 전분기 대비 45% 증가했으며, 3분기 조정 기준 흑자를 기록하였다. 이러한 변화는 AI 모델의 가격 하락에도 사용량 증가를 통해 서비스 매출이 확대될 수 있다는 점을 보여준다.

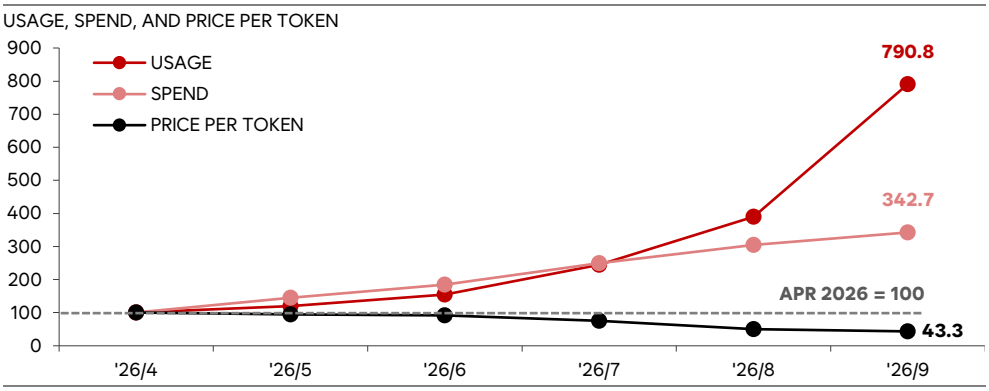
하이퍼스케일러 실적에서 클라우드·AI 매출 고성장이 확인

최근 하이퍼스케일러와 AI 인프라 기업들의 실적에서도 AI 관련 매출 증가가 확인되고 있다. Microsoft는 FY1Q27 Azure 매출액이 전년 대비 48% 증가했으며, 상업용 잔여계약금액(RPO)은 6,770억 달러로 73% 증가하였다. CAPEX가 452억 달러로 확대되었음에도 FCF는 186억 달러 흑자를 기록하였으며, 다음 분기 Azure 성장률을 49~50%로 전망하였다. Google도 3Q26 Google Cloud 매출액이 전년 대비 103% 증가한 307억 달러를 기록했으며, 자체 AI 모델 API 처리량은 전년 대비 4배 이상 증가하였다. 다만 CAPEX 514억 달러 집행으로 FCF는 -91억 달러를 기록하였다. Meta 역시 3Q26 매출액이 전년 대비 26% 증가했으며, AI를 활용한 광고 효율 개선이 기존 사업의 성장을 견인하고 있다. 2026년 CAPEX 전망도 1,350억~1,450억 달러로 유지하였다. Amazon은 3Q26 AWS 매출액이 전년 대비 39.3% 증가한 460억 달러를 기록하며 약 5년 만에 가장 높은 성장률을 달성하였다. AWS 영업이익은 178억 달러(+55% YoY), 영업이익률은 38.7%를 기록하였다. 특히 2027년과 2028년에도 AWS 매출액이 각각 40% 이상 증가할 것으로 전망하면서 2026년 CAPEX 계획 2,200억 달러를 유지하였다. 다만 AI 인프라 투자 확대에 따라 최근 12개월 FCF는 전년 148억 달러 흑자에서 424억 달러 적자로 전환되었다. AI 컴퓨팅 인프라 사업을 확대하고 있는 SpaceX 역시 3Q26 매출액이 전년 대비 161% 증가한 146억 달러를 기록하였다. 특히 Super Intelligence(SI) 부문 매출액은 76억 달러(+830% YoY)로 증가했으며, 신규 클라우드 서비스 계약과 AI 모델 사용 확대, Cursor 인수 효과가 반영되었다. AI 컴퓨팅 설비 규모도 2026년 6월 말 1.4GW에서 9월 말 1.7GW로 확대되었으며, 3분기 SI 부문 CAPEX는 164억 달러를 기록하였다. 같은 기간 SI 부문 영업이익은 4.3억 달러를 기록해 흑자 전환했으나, 대규모 설비투자가 지속되고 있어 향후 현금창출 확대가 필요한 상황이다. 또한 1~3분기 누적 SI 부문 영업손실은 약 33억 달러로, 투자 확대에 따른 수익성 부담은 여전히 남아 있다.

단기 FCF 악화보다 매출 증가가 현금흐름 개선으로 이어지는지가 AI 투자 평가의 관건

기업별 FCF에는 차이가 있지만, Microsoft는 높은 CAPEX에도 현금흐름 흑자를 유지하고 있으며 Amazon은 FCF 적자에도 AWS 영업이익이 증가하고 있다. Google과 SpaceX에서도 AI 인프라 매출 확대가 확인되는 가운데 주요 기업들의 투자 계획이 유지되고 있다. 단기 FCF 악화만으로 AI 인프라 수요가 둔화되고 있다고 판단하기는 어렵다. 하이퍼스케일러들이 단기 현금흐름 부담에도 투자를 지속하는 것은 AI 컴퓨팅 수요가 공급능력을 초과하는 가운데, 데이터센터 증설에 상당한 시간이 소요되는 만큼 선제적인 CAPA 확보를 통해 향후 매출 기회 손실을 방지하기 위해서다. 다만 향후 투자 확대에 따른 매출 증가가 영업현금흐름과 FCF 개선으로 이어지는지 여부가 AI 투자 수익성에 대한 시장의 평가를 결정할 것으로 예상한다.

AI Gateway 토큰 사용량 · 사용액 및 평균 토큰 가격 추이



자료: Vercel, 한국IR협의회 기업리서치센터

AI 서버 수요 확대와 메모리 공급 제약, LTA 확대

Intel 데이터센터 부문 매출이 +78% YoY 증가하는 등 AI 서버 수요 확대 확인

반도체 업체의 실적 발표에서도 AI 인프라 수요 확대가 확인되고 있다. Intel은 3Q26 매출액 165억 달러(+21% YoY)를 기록했으며, 데이터센터 및 AI 부문(DCAI) 매출액은 73억 달러로 전년 대비 78% 증가하였다. 반면 PC 중심의 Client Computing and Physical AI 부문(CCPG) 매출액은 5% 감소해 서버와 일반 PC 시장의 수요 차이가 나타났다. 특히 Xeon 서버 CPU에 대한 주문이 공급능력을 초과하고 있어 생산능력 확대를 최우선 과제로 추진하고 있다.

NAND 시장에서는 데이터센터 중심 제품 믹스 변화와 가격 상승이 수익성 개선에 기여

NAND 시장에서도 데이터센터 수요 증가가 실적에 반영되고 있다. Sandisk는 2026년 10월 발표한 FY1Q27 실적에서 매출액 110.3억 달러(+23% QoQ), GAAP 매출총이익률 85.0%를 기록하였다. 특히 데이터센터 매출액은 48.0억 달러로 전분기 대비 61% 증가하며 성장을 주도하였다. 반면 Consumer 매출액은 전분기 대비 29% 감소해 데이터센터와 소비자용 제품의 수요 차이가 확대되었다. Sandisk는 데이터센터 고객사의 높은 수요를 기반으로 FY2Q27 매출액 122억~126억 달러를 전망하였다. 데이터센터 중심의 제품 믹스 변화와 가격 상승이 매출 및 수익성 개선에 기여하고 있으며, 기업용 SSD 중심의 NAND 수급도 우호적인 상황이다. Micron 역시 2027~2028년 글로벌 NAND Bit 출하량이 연간 20% 중반 증가하더라도 공급 부족이 지속될 것으로 전망하였다.

삼성전자·SK하이닉스는 신규 Fab 건설 시차와 HBM 비중 확대로 중장기 메모리 공급 부족 전망

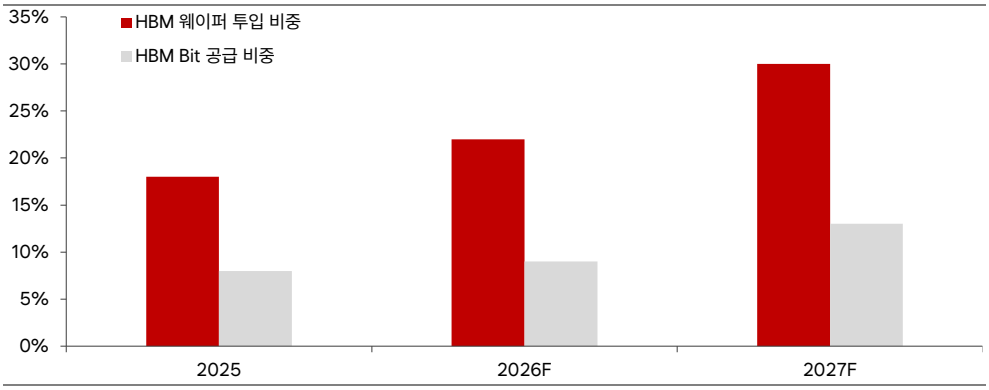
DRAM 업체들의 실적 발표에서도 중장기 공급 부족에 대한 전망이 유지되고 있다. 삼성전자는 3Q26 실적 발표에서 2028년까지 메모리 공급 부족이 지속될 것으로 예상했으며, 2027년 CAPEX 증가분 중 상당 부분이 신규 Clean Room 확보에 투입되는 데다 건설비와 장비 가격 상승으로 투자금액 증가가 실제 생산능력 확대로 이어지는 효과는 제한적일 것으로 전망된다. 또한 HBM 생산 비중 확대와 차세대 제품의 공정 복잡도 증가는 일반 DRAM에 배분할 수 있는 생산능력을 제약하는 요인으로 작용하고 있다. SK하이닉스 역시 선단 공정의 기술 난이도 상승과 신규 Fab 건설 기간을 고려하면 2030년까지 수요가 공급을 초과할 것으로 전망하였다. 특히 HBM 고객사들의 요구 물량이 현재 공급 가능한 물량의 2배를 넘어서고 있어 생산능력 확대에도 공급 부족이 지속되고 있다. 2027년 실제 공급 여력을 반영한 시장 수요 성장률은 DRAM 20%대 중반, NAND 10%대 후반으로 예상하고 있다. 또한 2027년 CAPEX를 대폭 확대할 계획이지만, 용인과 M17 등 신규 Fab은 건설을 선행하되 Clean Room 가동과 장비 반입, 양산 확대는 수요 및 수익성을 고려해 단계적으로 진행할 예정이다. 따라서 투자금액 증가가 단기간 내 Bit 공급 확대로 이어지는 효과는 제한적일 전망이다. Micron도 HBM 생산 확대와 DRAM 미세공정 전환에 따른 생산성 개선 둔화로 2027~2028년 공

급 증가가 제한적일 것으로 예상하고 있다. 특히 2027~2028년 글로벌 DRAM Bit 출하량 증가율을 연간 20% 초반으로 전망하면서도 공급 부족이 지속될 것으로 예상하였다. 따라서 메모리 업체들의 CAPEX 확대가 곧바로 동일한 비율의 Bit 공급 증가로 연결되기는 어려우며 신규 생산능력이 실제 공급에 기여하는 시점까지 수급 제약이 이어질 것으로 전망한다.

메모리 업체들의 LTA·SCA 확대로 과거와 다른 장기 수요 가시성 확보

특히 메모리 업체들의 LTA 및 전략적 고객계약(SCA) 확대는 과거 메모리 사이클과 구분되는 변화이다. 삼성전자는 3Q26 실적 발표에서 대형 고객사 10곳과 LTA 체결을 완료했으며, 추가로 10개 고객사와 협상을 진행하고 있다고 밝혔다. 이를 기반으로 2030년까지 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보하겠다는 목표의 달성 가능성도 높아졌다. SK하이닉스는 글로벌 주요 고객사 14곳과 LTA를 체결했으며, 계약 물량은 2027~2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다. 확정 계약과 고객사들과 구체적으로 협의 중인 수요를 합산하면 2029년까지 DRAM과 HBM 생산 물량이 사실상 모두 판매 가능할 것으로 예상하고 있다. Micron은 26건의 전략적 고객계약(SCA)을 체결했으며, DRAM과 NAND를 포함한 2030년까지 예상 매출액의 35% 이상이 해당 계약에 포함된다. 또한 2027년 생산 물량의 75% 이상이 SCA와 일반 고객의 구매 확약을 통해 확보되어 있다. 고객사들의 금융 약정 규모는 320억 달러로 확대되었으며, 대부분이 현금 예치금이다. 이러한 장기계약은 회사와 고객사에 따라 구매 이행 의무, 예치금, 가격 상·하한선 등을 포함하고 있어 과거의 일반적인 공급계약보다 구속력이 강화되었다. Micron의 SCA에는 고객의 구매 의무를 강화하는 Take-or-Pay 조건도 포함되어 있다. 특히 SK하이닉스는 합의된 가격 범위 내에서 시장 가격을 반영하는 구조를 도입했으며, Micron도 SCA 예상 매출액의 약 75%에 가격 결정 체계를 설정해 이 중 상당 부분에 가격 상·하한선을 적용하고 있다. 고객사 역시 계약을 이행하지 않을 경우 향후 공급 부족 국면에서 물량 확보에 불리해질 수 있어 장기적인 공급 관계를 유지할 유인이 높다. 이에 따라 LTA 확대는 메모리 업체들의 중장기 수요 가시성을 높이고 공급 확대에 따른 가격 하락 위험과 실적 변동성을 완화하는 요인으로 작용할 것으로 전망된다.

HBM의 DRAM 웨이퍼 투입량 및 Bit 공급 비중 추이



자료: Trendforce, 한국IR협의회 기업리서치센터

4 반도체 CAPA 확대와 공정 고도화에 따른 소모성 부품 수요 증가

글로벌 반도체 소모성 부품·서브시스템 시장은 2026년 206억 달러(+13.8% YoY) 전망

AI 인프라 수요 확대와 DRAM, NAND 생산능력 투자는 반도체 장비뿐 아니라 관련 소모성 부품 및 핵심 서브시스템 시장의 성장으로 이어질 전망이다. 글로벌 반도체 소모성 부품 및 서브 시스템(Consumables & Critical Subsystems) 시장은 2025년 181억 달러에서 2026년 206억 달러로 전년 대비 13.8% 성장할 것으로 전망된다. 소모성 부품 및

서브 시스템에는 쿼츠, 실리콘, 세라믹 부품, 정전척(ESC), 가스 및 케미칼 전달 시스템 등이 포함되어 있다. 다만 전체 시장에는 정기적으로 교체하는 공정 부품뿐 아니라 장비에 장착되는 핵심 서브시스템도 포함되어 있어 제품별 수요와 교체 특성에는 차이가 있다.

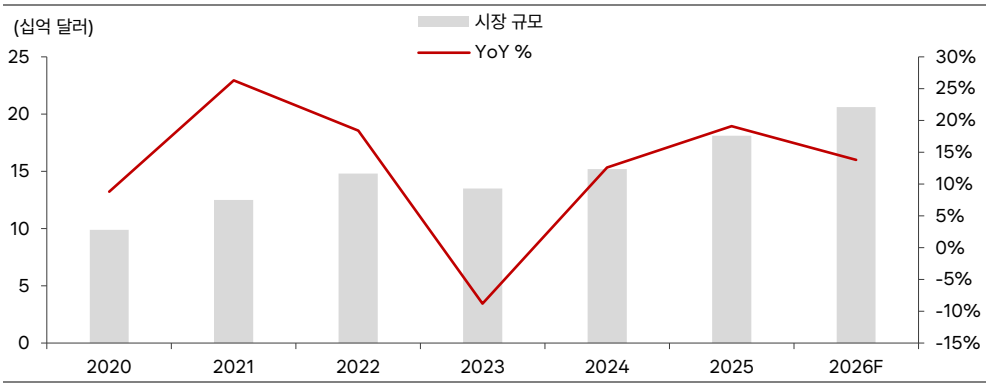
소모성 부품은 장비 대비 변동성이 완만하며 업사이클에는 초도 장착과 교체 수요가 동반 증가

반도체 소모성 부품 시장 성장 요인은 반도체 CAPA 증가, 공정 난이도 상승, 신규 소재 채택, 어드밴스드 패키징 도입 등이다. 소모성 부품 시장은 반도체 장비 대비 변동성이 완만한 모습을 보인다. 반도체 다운 사이클에는 신규 장비 발주가 감소하더라도 기존 장비의 가동에 따른 부품 교체 수요가 유지되기 때문이다. 다만 가동률이 하락하면 장비 사용 시간이 감소해 교체 수요도 줄어들 수 있다. 반대로 업사이클에서는 신규 장비의 초도 장착 수요가 증가하고, 신규 생산라인이 가동되면서 기존 장비의 교체 수요에 추가적인 반복 수요가 발생한다. 특히 부품 교체 수요는 가동 중인 장비 수와 장비당 부품 장착 수량, 실제 가동시간 및 부품 수명에 영향을 받는다. 최근에는 DRAM 중심의 메모리 투자와 선단 공정 위주의 Foundry Fab 투자로 신규 장비의 초도 장착 부품 수요가 확대되고 있으며, 장비 가동 이후에는 교체 수요가 추가될 전망이다.

미세화·고단화로 공정 환경이 가혹해지며 SiC 등 고내구성 부품 채택 확대 가능

반도체 공정 난이도 증가도 부품 수요를 확대하는 요인이다. 반도체 미세화가 진행되고 적층 수가 높아질수록 부품이 견뎌야 하는 제조 환경이 가혹해진다. NAND의 경우 300단 이상의 고단화로 인해 채널 홀 식각의 종횡비(Aspect Ratio)가 높아지고, 깊고 좁은 구조를 정밀하게 식각하기 위한 공정 제어의 중요성이 증가하고 있다. 이에 따라 식각시간과 공정 반복 횟수, 플라즈마 노출 조건 등이 변화하면서 챔버 내부 부품의 마모에도 영향을 미칠 수 있다. 다만 교체주기는 실제 플라즈마 조건과 부품 소재, 내구성 개선 여부에 따라 달라지므로 공정 난이도 상승이 모든 부품의 교체 주기 단축으로 이어지는 것은 아니다. 이러한 공정 환경 변화로 높은 내플라즈마성과 내식성, 낮은 파티클 발생 특성을 갖춘 SiC 및 고순도 세라믹 등의 부품 적용이 확대될 수 있다. 소재 변경으로 제품 단가가 상승할 가능성이 있지만, 부품 수명 연장에 따른 교체 수량 감소도 함께 고려할 필요가 있다. 또한 HBM의 TSV와 이종집적 패키징 공정에서는 깊은 식각, 세정 및 CMP 공정의 적용이 확대되고 있어 관련 장비의 설치 기반 증가에 따른 부품 수요도 추가될 전망이다.

글로벌 반도체 소모성 부품 및 서브 시스템 시장 규모 추이



자료: Techinshights, 한국IR협의회 기업리서치센터

투자포인트

1 DRAM 투자 확대와 NAND 고단화가 이끄는 SiC Focus Ring 수요 증가

DRAM 신규 CAPA 증설과 NAND 고단화 전환으로 SiC Focus Ring 수요 증가 전망

반도체 업체들의 DRAM 신규 CAPA 증설과 NAND 고단화 전환에 따라 동사의 SiC Focus Ring 수요가 증가할 전망이다. SiC Focus Ring은 반도체 식각 챔버에서 웨이퍼 가장자리를 둘러싸 플라즈마의 이온 입사각과 식각 균일성을 유지하는 소모성 부품이다. 특히 산화막과 질화막의 고종횡비 식각 공정에 주로 사용되며, 미세화 및 고단화로 공정 난이도가 증가할수록 SiC 소재의 내플라즈마성과 낮은 파티클 발생 특성이 중요해진다. 따라서 SiC Focus Ring 수요는 신규 CAPA와 가동률뿐 아니라 식각 공정의 변화에 따른 사용시간과 소재 채택률에도 영향을 받는다.

DRAM에서는 캐패시터 홀(Capacitor Hole)과 콘택트 홀(Contact Hole), NAND에서는 채널 홀(Channel Hole)과 슬릿(Slit) 등 고종횡비 식각 공정에 Focus Ring이 사용된다. DRAM은 미세화로 캐패시터 직경이 감소하지만 정전용량 유지를 위해 높이를 유지하거나 증가시켜야 하므로 종횡비(Aspect Ratio)가 높아진다. 이에 따라 균일한 식각이 어려워지고, Focus Ring 마모에 따른 이온 입사각 변화와 파티클 발생을 줄일 수 있는 SiC 소재의 채택이 확대된다. NAND는 적층수가 증가할수록 채널 홀의 식각 깊이가 길어지며, 한 번의 식각으로 구현하기 어려워 여러 개의 Stack으로 나누어 형성한다. 삼성전자 V9은 Double Stack, SK하이닉스 321단은 3-Plug 기술을 도입했으며, 삼성전자 V10은 Triple Stack을 적용한다. 이러한 공정 변화는 식각 횟수와 장비의 누적 플라즈마 노출시간을 증가시켜 Focus Ring의 교체 수요 확대 요인으로 작용한다.

DRAM 업체들의 신규 CAPA 투자도 확대되고 있다. 삼성전자는 P4의 Ph2와 Ph4에 1c DRAM 생산을 위한 전공정 장비 투자를 진행하고 있으며, 2027년 1분기까지 신규 생산라인 구축을 추진하고 있다. 또한 평택 P5 Ph1의 장비 반입 시점을 기존 2027년 3분기에서 2분기로 앞당기는 방안을 추진하고 있으며, 2028년 본격 가동을 목표로 하고 있다. SK하이닉스는 M15X의 양산 일정을 앞당겨 생산능력을 확대하고 있으며, 2027년 2월에는 용인 1기 Fab의 첫 번째 클린룸을 개설할 계획이다. Micron도 대만 Tongluo Fab의 설비 확충을 통해 2027년 중반부터 제품 출하를 확대하고, 미국 Idaho 첫 번째 Fab에서도 2027년 중반부터 웨이퍼 생산을 시작할 예정이다. 이에 따라 신규 식각 장비의 초도 물량과 CAPA 가동에 따른 교체 수요가 순차적으로 증가할 것으로 전망한다.

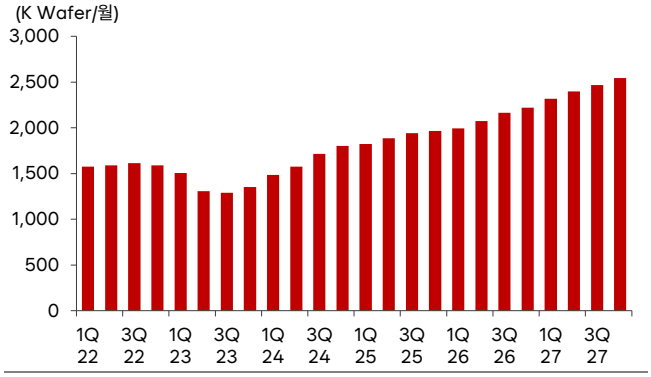
메모리 업체들의 NAND 고단화 전환투자도 확대되고 있다. 삼성전자는 중국 시안 Fab의 기존 200단 내외 NAND 생산라인을 286단 V9 공정으로 전환하고 있다. SK하이닉스는 2026년 말까지 국내 NAND 생산능력의 약 50%를 321단 공정으로 전환할 계획이다. 솔리다임의 중국 다롄 Fab에서도 기존 192단 NAND를 240단 이상으로 전환하는 투자를 추진하고 있다. NAND는 신규 Wafer CAPA 확대가 제한적이지만, 기존 라인의 고단화에 따른 식각 공정 증가와 SiC 채택 확대가 Focus Ring 수요를 견인할 것으로 전망된다.

동사는 글로벌 SiC Focus Ring Before Market에서 약 90%의 점유율을 확보하고 있어 신규 장비 공급과 기존 장비의 교체 수요 증가에 따른 수혜가 예상된다. 2026년 상반기에는 DRAM 투자에 따른 A사와 S사향 공급이 증가했으며, 하반기부터는 NAND 고단화 라인의 가동 확대와 함께 L사향 물량이 증가하고 있다. 특히 솔리다임 다롄 Fab에서 기

존 After Market으로 공급되던 일부 물량이 L사를 통한 Before Market 공급으로 전환되면서 3분기부터 매출에 반영되고 있다. 2027년에도 DRAM 신규 CAPA와 NAND 고단화 라인의 가동 확대에 따라 SiC Focus Ring 수요 증가세가 이어질 것으로 예상된다.

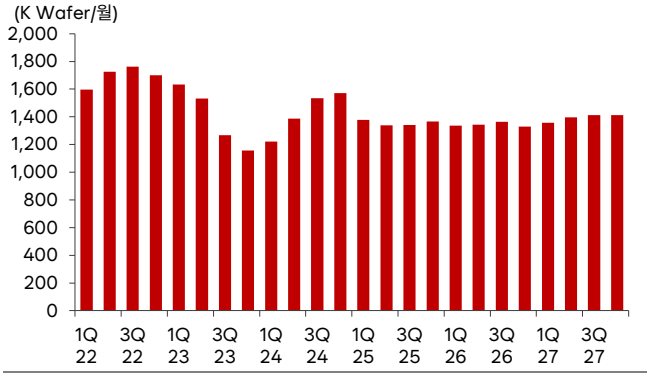
동사는 고객사 수요 증가에 대응하기 위해 CAPA 증설을 추진하고 있다. 현재 약 4,000억 원의 연간 매출 CAPA를 보유하고 있으며, 높은 가동률로 생산능력 확대가 필요한 상황이다. 기존 공장 내 설비 증설과 생산 효율화를 통해 2027년 하반기 생산능력을 기존 대비 약 20~30% 확대할 계획이다. 신규 설비는 2027년 상반기 투자 완료 후 하반기부터 가동할 예정이며, 중장기 수요 대응을 위한 신규 공장 투자도 추진해 2028년 양산을 목표로 하고 있다. 신규 CAPA 가동에 따른 매출 증가와 고정비 부담 완화가 수익성 개선에 기여할 것으로 전망한다.

글로벌 DRAM CAPA 전망



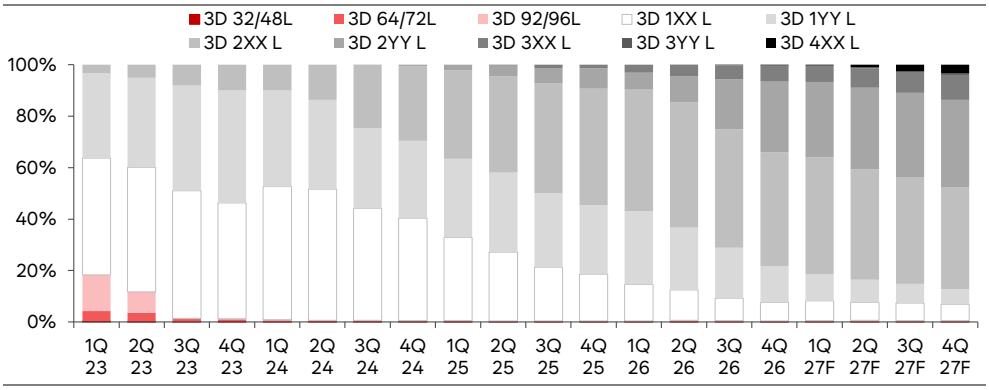
자료: 업계자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 NAND CAPA 전망



자료: 업계자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 NAND 공정별 비율



자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 Logic과 HBM으로 확대되는 SiC 적용 시장

SiC Focus Ring 적용처를 선단 Logic과 HBM TSV 식각 공정으로 확대 추진

동사는 기존 DRAM과 NAND의 전공정 식각 중심이었던 SiC Focus Ring 적용처를 선단 Logic과 HBM TSV 식각 공정으로 확대하고 있다. 특히 Logic은 기존 SiC 적용이 제한적이었던 시장으로, 신규 채택이 이루어질 경우 동사의 SiC Focus Ring 시장 확대에 기여할 전망이다.

선단 Logic은 미세화가 진행되면서 기존 FinFET에서 GAA(Gate-All-Around) 구조로의 전환이 확대되고 있다. GAA는 여러 개의 Nanosheet 채널을 수직으로 적층하고 Gate가 이를 둘러싸는 구조로, 복잡한 3차원 형상을 정밀하게 구현하기 위한 식각 기술이 요구된다. 특히 Conductor Etch 공정에서는 미세한 패턴의 치수와 식각 균일성을 유지해야 하므로 플라즈마 제어와 파티클 저감이 중요하다. 기존 Logic은 NAND와 식각 조건이 달라 SiC Focus Ring의 적용이 제한적이었으나, 공정 미세화에 따른 정밀도 요구와 신규 식각 장비 도입으로 SiC 채택이 검토되고 있다. 동사는 L사와 장비 테스트를 완료했으며, 현재 파운드리 업체와 퀄을 진행하고 있다. 2026년 말 인증 완료가 예상된다.

HBM에서는 DRAM Die를 수직으로 연결하기 위한 TSV(Through Silicon Via) 식각 공정에 SiC Focus Ring 적용이 추진되고 있다. TSV는 실리콘 웨이퍼에 미세한 홀을 형성한 뒤 전도성 물질을 채워 적층된 Die 사이를 연결하는 기술이다. HBM4는 HBM3E 대비 데이터 I/O 수가 1,024개에서 2,048개로 증가했으며, 16단 적층 제품으로의 확대도 추진되고 있다. TSV 식각에서는 홀의 직경과 깊이, 형상을 균일하게 제어해야 하며, Focus Ring의 마모에 따른 플라즈마 분포 변화가 식각 형상과 수율에 영향을 미칠 수 있다. SiC는 기존 Si 대비 내식각성과 수명이 우수해 장시간 공정에서 안정적인 식각 환경을 유지하는 데 유리하다. 동사는 L사와 TSV 식각용 SiC Focus Ring의 인증을 진행 중이며, 2026년 말 인증 완료와 2027년 양산 적용이 기대된다. 향후 HBM 생산 확대와 SiC 채택이 이루어질 경우 신규 장비의 초도 장착과 가동에 따른 교체 수요가 발생할 것으로 전망한다.

SiC Shower Head는 식각 챔버 내부에 공정 가스를 균일하게 공급하는 부품으로, 기존 Si 소재의 수명 한계에 따라 SiC로의 전환이 진행되고 있다. 동사는 현재 중국 A사에 SiC Shower Head를 공급하고 있으며, 미국 A사와 일본 T사 등으로 공급 확대를 위한 테스트를 진행 중이다. SiC Shower Head는 Focus Ring 대비 판가가 약 5~6배 높아 신규 고객사 채택이 이루어질 경우 제품 다변화에 따른 추가적인 매출 성장이 기대된다.

FinFET과 GAA 트랜지스터 구조 비교

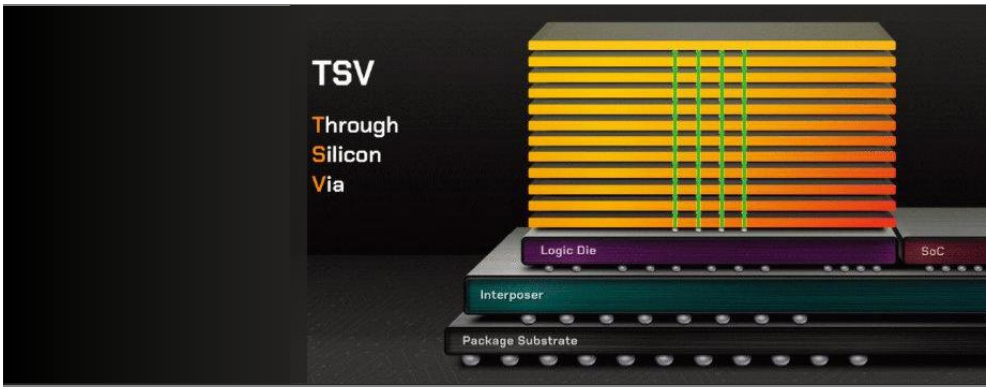


	FinFET	GAA (Gate-All-Around)
채널 형태 (Channels)	수직 핀 (Vertical Fins)	적층형 수평 나노시트 (Stacked Horizontal Nanosheets)
게이트 제어 (Gate Control)	3면 (3 Sides)	4면 (4 Sides, 전면 제어)
공정 복잡도 (Complexity)	보통 (Moderate)	높음 (High)

면적 밀도 (Area Density)	20% 향상 (↑ 20%)
성능 (Performance)	20% 향상 (↑ 20%)
소비 전력 (Power)	30% 절감 (↓ 30%)

자료: AMAT, 한국IR협의회 기업리서치센터

HBM TSV 구조



자료: SK하이닉스, 한국IR협의회 기업리서치센터

SiC 적용 공정 확대 현황

	Cryogenic Etch (저온 식각)	Deep Si Etch (심층 실리콘 식각)	Conductor Etch for 3D Structures (3D 구조용 도전체 식각)
주요 응용처 (Key Application)	• 3D NAND HAR (hole, trench, contact) • Capacitor Cell	• TSV for HBM and Packaging • CMOS Image Sensors • Advanced Power Devices	• GAA / CFET Transistor • 4F² DRAM / 3D DRAM • 3D NAND
SiC 시장 진입 기회 (SiC Market Opportunity)	Already Adopted (이미 도입됨)	Highly Possibility to Adopt (도입 가능성 매우 높음) ※ 이미 부분적으로 양산 출하 중	Testing Stage(테스트 단계) ※ 이미 부분적으로 양산 출하 중

자료: 티씨케이, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

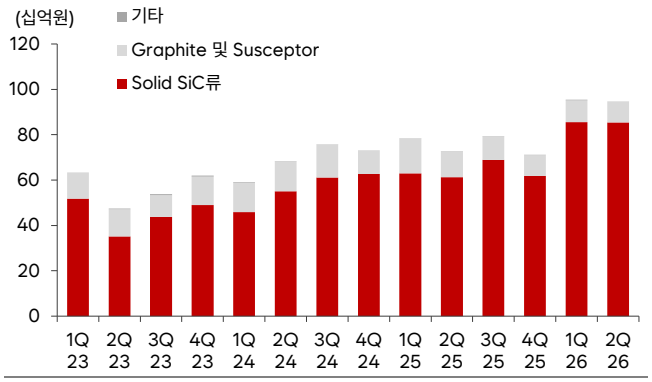
1 Solid SiC 성장에도 수익성 개선이 제한적이었던 2025년

2025년 매출액 3,013억 원(+9.3% YoY), 영업이익 839억 원(+3.9% YoY) 기록

2025년 동사는 매출액 3,013억 원(+9.3% YoY), 영업이익 839억 원(+3.9% YoY)을 기록하였다. 주력 제품인 Solid SiC 매출액은 2,548억 원(+13.5% YoY)을 기록하며 전사 성장을 견인하였다. 중국 주요 장비사향 SiC Ring 공급이 증가한 가운데, 국내 메모리 고객사의 NAND V8 공정 전환에 따른 수요가 확대되었다. NAND 신규 CAPA 투자는 제한적이었으나 고단화에 따른 식각 공정 변화와 SiC Focus Ring 채택 확대가 수요를 견인하였다. 또한 하반기부터 NAND 고객사의 가동률이 회복되면서 기존 장비의 교체 수요도 증가하였다. 다만 DRAM 신규 CAPA 투자가 제한적이었던 가운데, 하반기 중국 고객사의 재고조정과 4분기 일부 매출 이연이 2025년 연간 매출 성장률을 제한하는 요인으로 작용하였다. Susceptor 매출액은 124억 원(-32.6% YoY)으로 감소하였으며, Graphite 매출액은 337억 원(+4.4% YoY)으로 소폭 증가하였다.

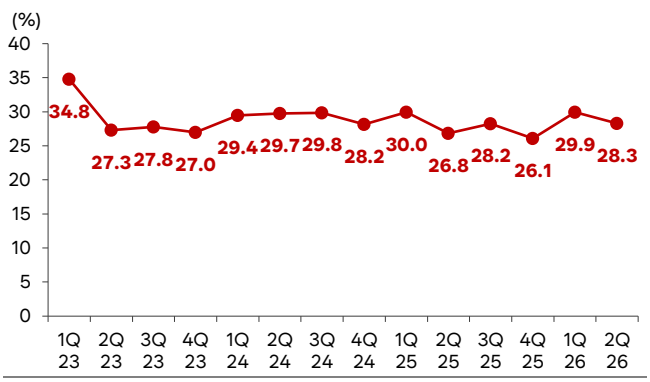
수익성 측면에서는 OPM 27.8%로 전년 대비 1.5%p 하락하였다. Solid SiC 매출 증가에도 불구하고 제조 외주용역비와 소모품비, 인건비가 증가하면서 매출원가율은 전년 62.2%에서 63.6%로 상승하였다. 또한 Solid SiC 매출 증가에 따른 판매지원 수수료와 급여 증가로 판관비도 전년 대비 10.6% 증가하며 수익성 개선을 제한하였다.

티씨케이 부문별 매출액 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 분기별 영업이익률 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 고객사 DRAM CAPA 증가와 NAND 고단화로 2026년 실적 성장

2026년 매출액 4,182억 원(+38.8% YoY), 영업이익 1,152억 원(+37.3% YoY) 전망

2026년 동사의 매출액 4,182억 원(+38.8% YoY), 영업이익 1,152억 원(+37.3% YoY)을 전망한다. 상반기 실적은 매출액 1,903억 원(+26.0% YoY), 영업이익 554억 원(+28.9% YoY)을 기록하였다. Solid SiC 매출액은 1,709억 원(+37.7% YoY)으로 증가하였다. DRAM 신규 CAPA 증설에 따른 A사와 S사향 공급이 증가했으며, NAND 고단화 전환에 따른 SiC Focus Ring 수요도 견조하게 유지되었다. 특히 1분기에는 4Q25에서 이연된 일부 매출이 반영되면서 매출액이 증가했으나, 2분기에는 높은 기저와 일부 고객사의 매출 인식 시점 변경으로 전분기 대비 소폭 감소하였다. 반면 Graphite 및 Susceptor 매출액은 190억 원(-28.5% YoY)으로 감소하였다.

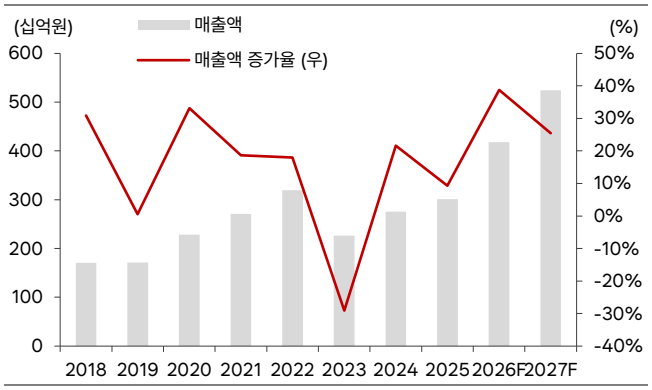
하반기에는 NAND 고단화 라인의 가동 확대와 DRAM 신규 CAPA 투자에 힘입어 Solid SiC 매출 증가세가 이어질 것으로 전망한다. NAND는 삼성전자 V9과 SK하이닉스 321단 등 고단화 공정의 생산 비중이 확대되면서 SiC Focus Ring 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 L사향 공급이 확대되고 있다. 또한 솔리다임 다롄 Fab에서 기존 After Market으로 공급되던 일부 물량이 L사를 통한 Before Market 공급으로 전환되면서 3분기부터 매출에 반영되고 있다. DRAM 역시 신규 CAPA 증설에 따른 초도 공급과 신규 라인 가동에 따른 교체 수요 증가가 예상된다. 이에 따라 하반기 Solid SiC 매출액은 2,057억 원으로 상반기 대비 20.4% 증가할 것으로 예상한다. 연간 Solid SiC 매출액은 3,766억 원(+47.8% YoY), Graphite 및 Susceptor 매출액은 411억 원(-10.9% YoY)을 전망한다.

수익성 측면에서는 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화에도 불구하고 환율 하락이 영업이익률 개선을 제한할 것으로 예상한다. 동사는 전체 매출의 약 60%가 달러화로 발생하기 때문에 원화 강세 시 매출액의 원화 환산액이 감소하는 반면, 원화로 발생하는 인건비와 제조비용은 같은 비율로 감소하지 않는다. 특히 하반기에는 환율 하락의 영향이 확대되면서 NAND향 매출 증가와 자체 가동률 상승에 따른 수익성 개선 효과가 일부 상쇄될 것으로 예상된다. 이에 따라 하반기 영업이익률은 상반기 29.1% 대비 낮은 26.2%를 전망하며, 연간 영업이익률은 전년 대비 0.2%p 하락한 27.6%를 예상한다.

2027년 매출액 5,247억 원(+25.5% YoY), 영업이익 1,546억 원(+34.2% YoY) 전망

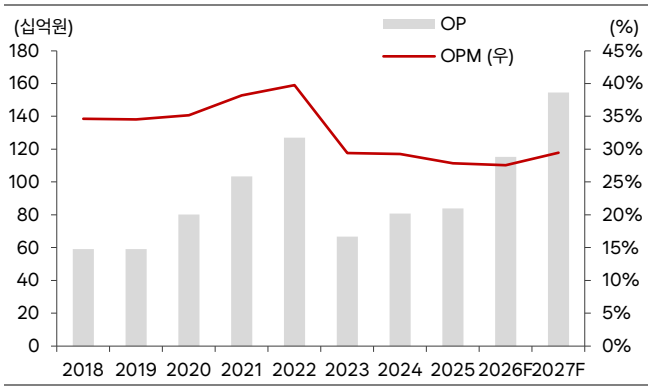
2027년 동사의 매출액은 5,247억 원(+25.5% YoY), 영업이익은 1,546억 원(+34.2% YoY)을 전망한다. DRAM 신규 CAPA 확대와 NAND 고단화 전환에 따른 SiC Focus Ring 수요 증가가 지속되는 가운데, 기존 설비 증설과 생산 효율화에 따른 CAPA 확대가 매출 성장에 기여할 것이다. Solid SiC 매출액은 4,764억 원(+26.5% YoY)을 예상한다. 수익성 측면에서는 매출 확대에 따른 고정비 부담 완화와 케이씨에 지급하던 판매지원 수수료 종료 효과로 영업이익률은 전년 대비 1.9%p 상승한 29.5%를 전망한다.

티씨케이 매출액 및 매출액 증가율 추이



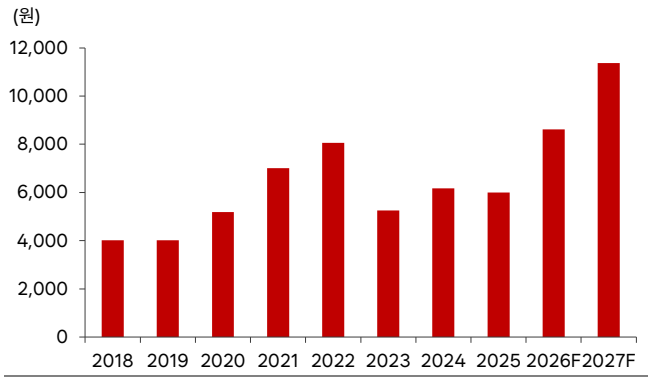
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 영업이익 및 영업이익률 추이



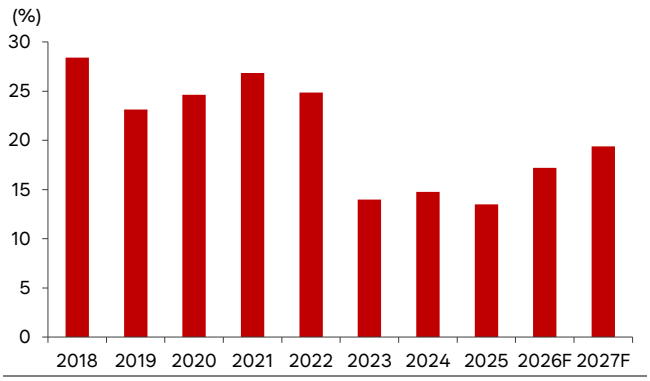
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 부문별 실적

(단위: 십억 원)

	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F	2027F
매출액	59.0	68.3	75.6	72.8	78.4	72.7	79.2	71.1	95.4	94.9	275.7	301.3	**418.2**	**524.7**
Solid SiC	45.8	55.0	61.1	62.6	62.9	61.2	68.8	61.8	85.5	85.4	224.5	254.8	**376.6**	**476.4**
Graphite 및 Susceptor	12.9	13.2	14.4	10.1	15.3	11.3	10.4	9.2	9.7	9.3	50.7	46.1	**41.1**	**47.7**
기타	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.4	**0.5**	**0.6**
영업이익	17.4	20.3	22.6	20.5	23.5	19.5	22.4	18.5	28.6	26.8	80.7	83.9	**115.2**	**154.6**
지배주주순이익	15.6	19.0	18.7	18.7	19.5	16.0	17.1	17.3	25.1	23.7	72.0	69.9	**96.4**	**127.2**
Margin(%)														
영업이익률	29.4	29.7	29.8	28.2	30.0	26.8	28.2	26.1	29.9	28.3	29.3	27.8	**27.6**	**29.5**
지배주주순이익률	26.4	27.8	24.8	25.6	24.9	22.0	21.6	24.3	26.3	24.9	26.1	23.2	**23.0**	**24.2**
YoYGrowth(%)														
매출액	-7.3	44.1	40.8	17.6	32.9	6.3	4.8	-2.4	21.7	30.5	21.7	9.3	**38.8**	**25.5**
Solid SiC	-11.6	56.7	39.7	28.0	37.4	11.4	12.7	-1.3	35.9	39.5	25.0	13.5	**47.8**	**26.5**
Graphite 및 Susceptor	12.3	9.9	48.9	-19.7	18.1	-14.5	-27.7	-9.6	-36.4	-17.8	10.6	-9.0	**-10.9**	**16.1**
기타	-16.8	-52.6	-50.5	-95.4	-28.3	-8.5	-96.7	456.3	14.6	15.0	-54.9	-27.6	**13.3**	**22.2**
영업이익	-21.5	56.8	51.3	22.7	35.1	-4.1	-0.8	-9.6	21.6	37.7	21.1	3.9	**37.3**	**34.2**
지배주주순이익	-8.0	27.8	8.7	53.1	25.2	-16.0	-8.4	-7.5	28.7	47.9	17.6	-2.9	**37.9**	**32.0**
QoQGrowth(%)														
매출액	-4.7	15.9	10.7	-3.8	7.7	-7.3	9.0	-10.3	34.2	-0.5				
Solid SiC	-6.4	20.0	11.1	2.5	0.4	-2.7	12.4	-10.2	38.3	-0.1				
Graphite 및 Susceptor	2.5	2.3	8.8	-29.7	50.8	-26.0	-8.0	-12.0	6.1	-4.3				
기타	-25.2	-40.7	-0.7	-89.5	1,056.3	-24.3	-96.4	1,680.0	138.2	-24.1				
영업이익	4.0	17.0	11.0	-9.1	14.5	-16.9	14.7	-17.2	54.1	-6.0				
지배주주순이익	28.0	22.1	-1.6	-0.4	4.7	-18.1	7.2	0.7	45.5	-5.8				

자료: FnGuide QuantiWise, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

1 2026F PER 20.6x

현주가는 2026F PER 20.6x, 2027F PER 15.6x로 Historical PER Band 중단 하회

동사의 현주가는 2026F PER 20.6x, 2027F PER 15.6x로 Historical PER Band(10.7x~47.0x) 중단을 하회하는 수준이다. Peer는 국내 반도체 파츠 업체인 하나머티리얼즈, 원익QnC, 월덱스, 케이엔제이, 씨엠티엑스를 선정하였다. 이들 기업은 Si, SiC, Quartz 등 반도체 식각 공정에 사용되는 소모성 부품을 공급하고 있으며, 반도체 업체들의 신규 CAPA 투자와 가동률, 공정 고도화에 따라 부품 수요가 증가한다는 공통점이 있다. 또한 신규 장비의 초도 장착뿐 아니라 기존 장비의 가동에 따른 반복적인 교체 수요가 발생한다는 점에서 동사와 사업구조가 유사하다.

동사의 2026F PER는 20.6x로 Peer 평균 9.0x 대비 약 129% 할증되어 거래되고 있다. 이러한 Premium은 경쟁사 대비 높은 수익성과 SiC Focus Ring 시장에서의 높은 점유율을 반영한 것으로 판단된다. 동사의 2026F 영업이익률은 27.6%로 Peer 평균 22.6%를 상회한다. 과거 SiC Ring 제조공정 관련 특허소송과 경쟁사 진입으로 시장 독점력에 대한 우려가 부각되었으나, 동사는 여전히 글로벌 SiC Focus Ring Before Market에서 약 90%의 점유율을 유지하고 있다. 이는 주요 반도체 장비사와의 공급 관계 및 고객사 인증에 따른 진입장벽이 OEM 시장에서 동사의 점유율을 방어하는 요인으로 작용하고 있기 때문이다. 또한 높은 OEM 시장 점유율을 기반으로 신규 장비의 초도 공급뿐 아니라 동사 제품이 채택된 장비의 설치 기반 확대에 따른 교체 수요도 확보할 수 있다는 점이 Valuation Premium의 이유이다.

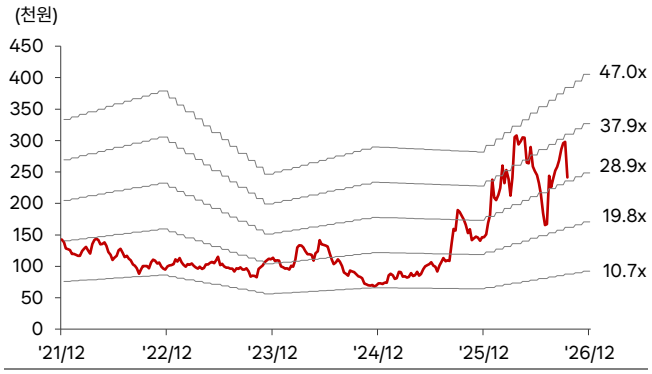
기존 메모리 중심의 SiC Focus Ring 적용 시장을 선단 Logic과 HBM TSV 공정으로 확대 시 추가적인 Valuation Premium 부여가 가능하다고 판단된다. 특히 Logic은 기존 SiC Focus Ring의 적용이 제한적이었던 시장으로, 신규 공정에서 양산 채택이 이루어질 경우 동사의 공급 가능 시장이 확대될 것으로 전망한다. HBM TSV 역시 기존 메모리 전공정과 다른 식각 공정으로 신규 장비 공급 이후 반복적인 교체 수요가 발생할 수 있으며 HBM 시장 성장의 수혜를 기대할 수 있다. 신규 적용처 확보는 기존 NAND와 DRAM의 투자 사이클에 집중되었던 수요 기반을 다변화하고 중장기 성장에 대한 가시성을 높일 것으로 판단된다. 향후 고객사 인증 완료와 양산 공급이 확인될 경우 기존 사업의 시장 지배력에 신규 적용처 확대에 대한 성장 기대가 더해지며 추가적인 Valuation Premium이 기대된다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억 원,백만 달러)	매출액(십억 원,백만 달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F
코스피	5,649	4,502,476	3,919,857	4,156,887	4,766,031	15.5	5.5	3.9	1.3	1.4	1.0
코스닥	704	399,381	361,554	141,360	161,628	112.9	20.1	14.4	2.1	2.3	2.0
티씨케이	**177,700**	**1,987**	**301**	**418**	**525**	**23.7**	**20.6**	**15.6**	**3.1**	**3.3**	**2.8**
하나머티리얼즈	46,300	916	273	379	461	22.2	12.5	9.1	1.8	1.4	1.2
원익QnC	25,500	670	944	1,095	1,223	25.1	9.7	7.9	1.2	1.2	1.1
월덱스	24,850	410	292	311	311	8.7	6.7	-	1.0	1.0	-
케이엔제이	24,700	198	84	151	180	6.8	8.6	5.4	1.8	1.6	1.2
씨엠티엑스	42,400	409	161	203	281	N/A	7.5	5.5	5.2	1.7	1.3
동종업종 평균						**15.7**	**9.0**	**7.0**	**2.2**	**1.4**	**1.2**

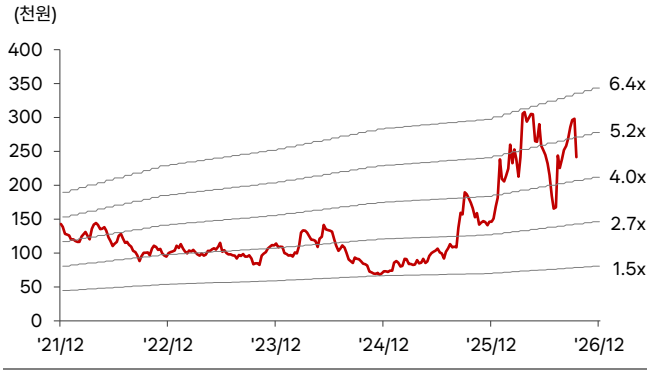
주: 1) 2026년 11월 03일 종가 기준. 동종그룹 26F, 27F는 시장 컨센서스 사용, 2) 월덱스 26F는 당사 추정치 사용, 27F는 컨센서스 없음, 자료: FnGuide QuantiWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 PER Band



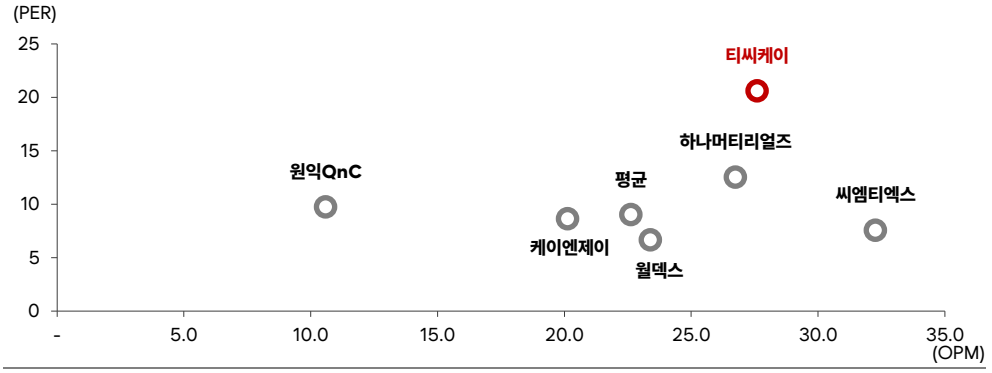
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

티씨케이 및 Peer 기업 OPM-PER



자료: FnGuide QuantiWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인

1 SiC Focus Ring 시장 경쟁 심화 가능성

SiC Focus Ring Before Market 경쟁 심화에 따른 점유율 및 ASP 하락 가능성

동사의 주요 리스크 요인은 SiC Focus Ring Before Market의 경쟁 심화에 따른 점유율 하락 가능성이다. 동사는 주요 반도체 장비사와의 공급 관계 및 고객사 인증을 기반으로 글로벌 Before Market에서 약 90%의 점유율을 유지하고 있다. 다만 경쟁사들이 주요 반도체 장비사의 제품 인증을 확보해 신규 장비 공급에 진입할 경우 동사의 초도 공급 비중이 축소될 수 있다. 또한 경쟁사 제품이 채택된 장비의 설치 기반이 확대되면서 향후 OEM 교체용 부품 공급에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 특히 SiC Focus Ring이 전체 매출의 약 80%를 차지하는 주력 제품인 만큼, 점유율 하락에 따른 판매량 증가폭 축소와 가격 경쟁 심화에 따른 ASP 하락은 매출액 및 영업이익 추정치의 하향 요인으로 작용할 수 있다. 또한 동사는 2026F PER 기준 Peer 대비 약 132% 할증되어 거래되고 있어, 높은 OEM 시장 점유율 유지에 대한 기대가 약화될 경우 Valuation Premium이 축소될 가능성도 존재한다.

포괄손익계산서

(억 원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
매출액	2,267	2,757	3,013	4,182	5,247
증가율(%)	-29.1	21.7	9.3	38.8	25.5
매출원가	1,347	1,716	1,916	2,760	3,432
매출원가율(%)	59.4	62.2	63.6	66.0	65.4
매출총이익	919	1,041	1,098	1,422	1,816
매출이익률(%)	40.6	37.8	36.4	34.0	34.6
판매관리비	252	234	259	270	270
판관비율(%)	11.1	8.5	8.6	6.5	5.1
EBITDA	818	958	979	1,330	1,783
EBITDA 이익률(%)	36.1	34.8	32.5	31.8	34.0
증가율(%)	-42.0	17.2	2.2	35.9	34.0
영업이익	667	807	839	1,152	1,546
영업이익률(%)	29.4	29.3	27.8	27.6	29.5
증가율(%)	-47.5	21.1	3.9	37.3	34.2
영업외손익	85	100	75	83	99
금융수익	89	93	83	89	105
금융비용	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-3	7	-8	-6	-6
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	753	907	914	1,235	1,645
증가율(%)	-41.2	20.6	0.7	35.2	33.1
법인세비용	140	187	215	272	373
계속사업이익	612	720	699	964	1,272
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	612	720	699	964	1,272
당기순이익률(%)	27.0	26.1	23.2	23.0	24.2
증가율(%)	-34.9	17.6	-2.9	37.9	32.0
지배주주지분 순이익	612	720	699	964	1,272

재무상태표

(억 원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
유동자산	3,345	4,058	4,156	4,890	5,908
현금성자산	318	339	418	417	296
단기투자자산	1,935	2,520	2,400	2,856	3,584
매출채권	406	476	458	648	813
재고자산	659	688	851	929	1,166
기타유동자산	27	35	28	40	50
비유동자산	1,610	1,578	1,520	1,650	1,881
유형자산	1,572	1,500	1,415	1,540	1,767
무형자산	22	24	22	19	16
투자자산	8	41	65	73	80
기타비유동자산	8	13	18	18	18
자산총계	4,955	5,635	5,676	6,540	7,789
유동부채	352	446	449	497	624
단기차입금	0	0	0	0	0
매입채무	61	97	115	144	181
기타유동부채	291	349	334	353	443
비유동부채	21	27	35	46	57
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	21	27	35	46	57
부채총계	372	473	483	544	681
지배주주지분	4,583	5,163	5,193	5,997	7,109
자본금	58	58	58	58	58
자본잉여금	63	63	63	63	63
자본조정 등	0	0	0	0	0
기타포괄이익누계액	0	0	-4	-4	-4
이익잉여금	4,462	5,041	5,076	5,880	6,991
자본총계	4,583	5,163	5,193	5,997	7,109

현금흐름표

(억 원)	2023	2024	2025	2026F	2027F
영업활동으로인한현금흐름	210	744	541	761	1,072
당기순이익	612	720	699	964	1,272
유형자산 상각비	147	147	137	175	234
무형자산 상각비	4	4	4	3	3
외환손익	6	2	5	0	0
운전자본의감소(증가)	-366	-108	-142	-221	-277
기타	-193	-21	-162	-160	-160
투자활동으로인한현금흐름	-336	-720	44	-764	-1,195
투자자산의 감소(증가)	0	0	0	-8	-7
유형자산의 감소	0	1	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-474	-76	-45	-300	-460
기타	138	-645	89	-456	-728
재무활동으로인한현금흐름	-3	-3	-505	2	2
차입금의 증가(감소)	0	0	0	2	2
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	-3	-3	-505	0	0
기타현금흐름	0	0	-0	0	0
현금의증가(감소)	-129	21	80	-1	-121
기초현금	447	318	339	418	417
기말현금	318	339	418	417	296

주요투자지표

	2023	2024	2025	2026F	2027F
P/E(배)	21.2	11.5	23.7	20.6	15.6
P/B(배)	2.8	1.6	3.1	3.3	2.8
P/S(배)	5.7	3.0	5.5	4.8	3.8
EV/EBITDA(배)	13.1	5.7	14.1	12.5	9.0
배당수익률(%)	1.1	2.0	1.0	0.8	0.8
EPS(원)	5,246	6,167	5,996	8,620	11,375
BPS(원)	39,252	44,219	46,452	53,641	63,586
SPS(원)	19,414	23,617	25,849	37,405	46,936
DPS(원)	1,200	1,410	1,430	1,430	1,430
수익성(%)					
ROE	14.0	14.8	13.5	17.2	19.4
ROA	12.5	13.6	12.4	15.8	17.7
ROIC	28.8	27.5	27.6	35.8	40.6
안정성(%)					
유동비율	950.8	910.3	926.5	983.7	947.2
부채비율	8.1	9.2	9.3	9.1	9.6
순차입금비율	-49.0	-55.1	-54.1	-54.4	-54.4
이자보상배율	2,417.3	2,525.7	2,262.2	3,489.2	3,905.6
활동성(%)					
총자산회전율	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7
매출채권회전율	5.8	6.3	6.5	7.6	7.2
재고자산회전율	3.9	4.1	3.9	4.7	5.0

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
티씨케이	O	X	X

2026년 08월 05일 매매관여과다에 따른 투자주의종목으로 지정된 바 있음.

발간 History

발간일	제목
2026.11.05	티씨케이-증설과 고단화에 신규 적용처까지
2025.01.31	티씨케이-SiC Focus Ring 글로벌 1위 기업

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.